

KT312

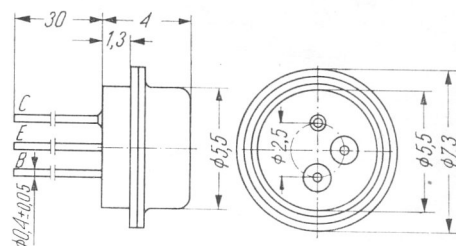
Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: ZSRR

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny *n-p-n* małej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie metalowej

Zastosowanie: odbiorniki radiowe i telewizyjne

Typy podobne: BFP521 (Cemi), BSY72÷75, 2N702/703, 2N5217



Rys. 1-1327. KT312

Wartości charakterystyczne¹⁾

	KT312A	KT312B	KT312B		
I_{CB0}	10		10	μA	przy $U_C = 15 V$
I_{EB0}		10		μA	przy $U_C = 30 V$
I_{EB0}	10	10	10	μA	przy $U_E = 4 V$
U_{CB0}	15	30	15	V	
U_{CEsat}	0,8	0,8	0,8	V	przy $I_C = 20 mA, I_B = 2 mA$
U_{BEsat}	1,1	1,1	1,1	V	przy $I_C = 20 mA, I_B = 2 mA$
C_c	5	5	5	pF	przy $U_C = 10 V, f = 10 MHz$
C_e	20	20	20	pF	przy $U_E = 1 V, f = 10 MHz$
$r_{b'b} C_c$	500	500	500	ps	przy $U_C = 10 V, I_E = 5 mA, f = 5 MHz$
f_T	80	120	120	MHz	przy $U_C = 10 V, I_E = 5 mA$
h_{21E}	10÷100	25÷100	50÷280		przy $U_C = 2 V, I_E = 2 mA$

Wartości graniczne

	30	30	30	
$I_C max$	30	30	30	mA
$U_{CB0} max$	15	30	15	V
$U_{CER} max$ ²⁾	15	30	15	V
$U_{EB0} max$	4	4	4	V
$P_{tot} max$ ³⁾	225	225	225	mW
$P_{Mtot} max$ ⁴⁾	450	450	450	mW
$R_{th j-a} max$ ⁵⁾	0,4	0,4	0,4	°C/mW
$t_j max$	115	115	115	°C
t_{amb}		-40 ÷ +85		°C

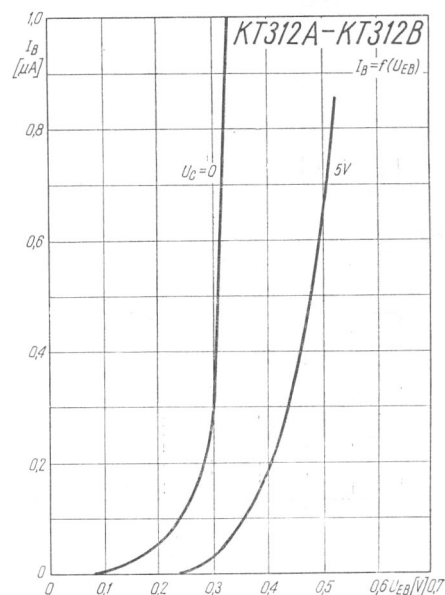
¹⁾ $t_{amb} = 20^\circ C (\pm 5^\circ)$

²⁾ $R_{BE} \leq 10 \Omega$

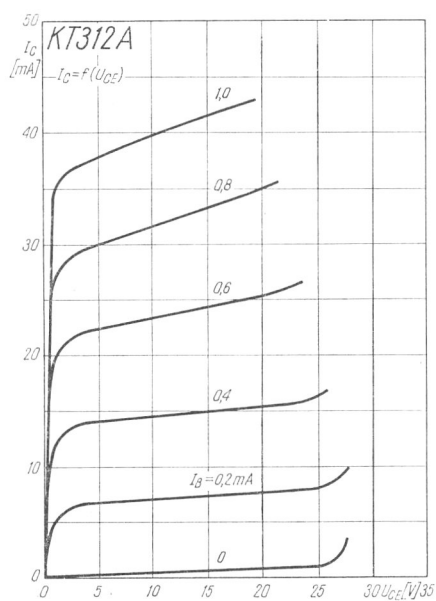
³⁾ $t_{amb} \leq 60^\circ C$

⁴⁾ $t_{amb} \leq 60^\circ C, t_p \leq 1 \mu s$

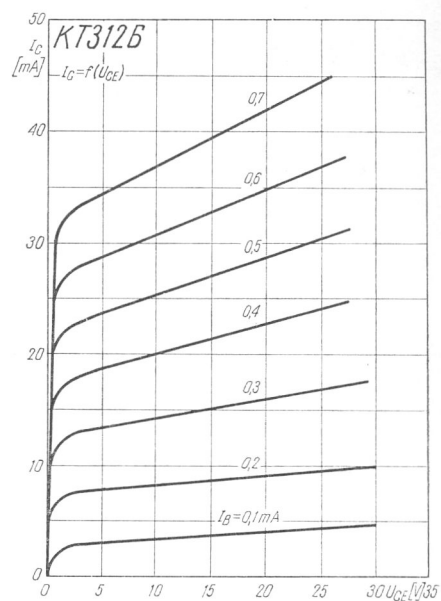
⁵⁾ $t_{amb} = 60 \div 85^\circ C$



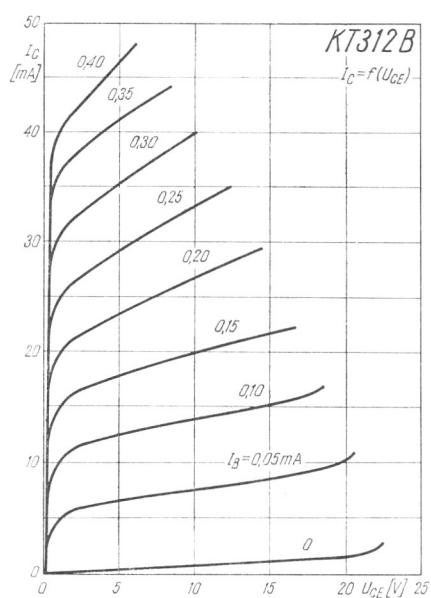
Rys. 1-1328. Charakterystyki wejściowe



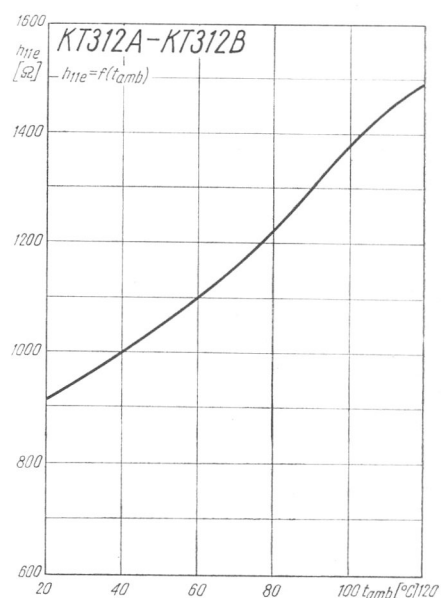
Rys. 1-1329. Charakterystyki wyjściowe



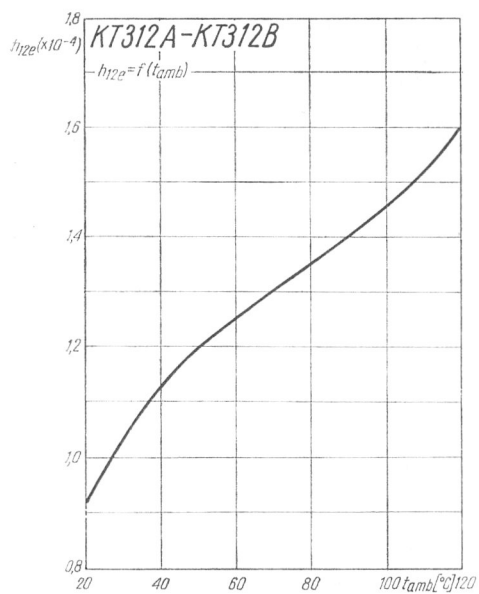
Rys. 1-1330. Charakterystyki wyjściowe



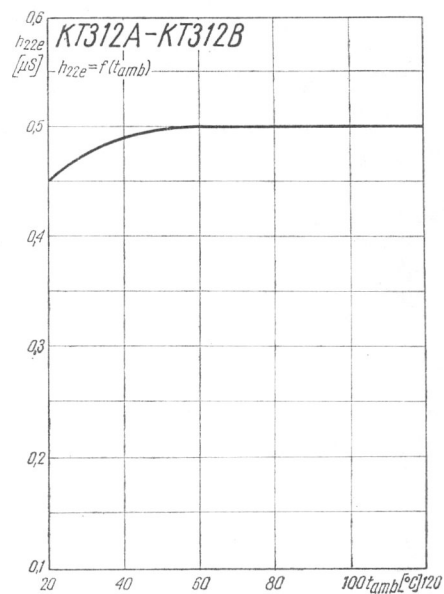
Rys. 1-1331. Charakterystyki wyjściowe



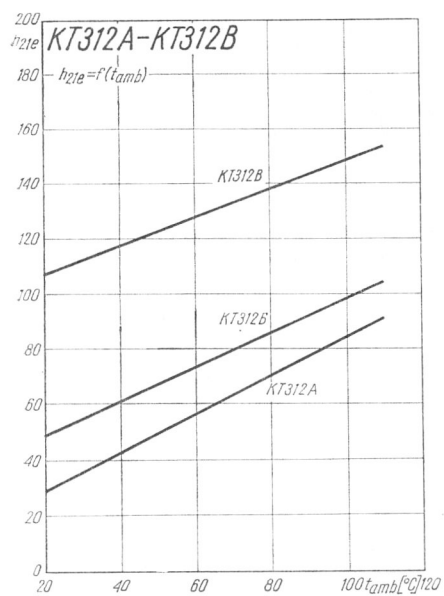
Rys. 1-1332. Zależność impedancji wejściowej od temperatury otoczenia



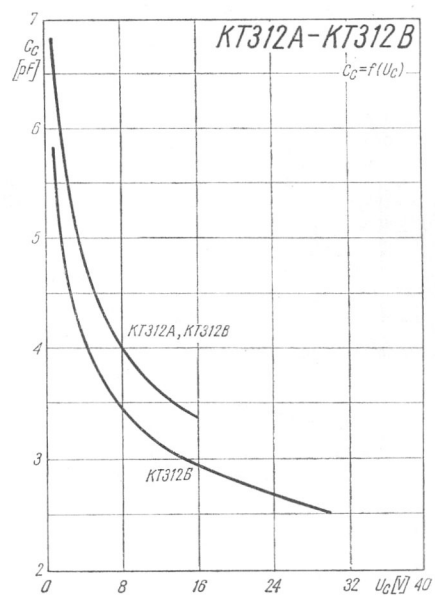
Rys. 1-1333. Zależność współczynnika sprzężenia zwrotnego od temperatury otoczenia



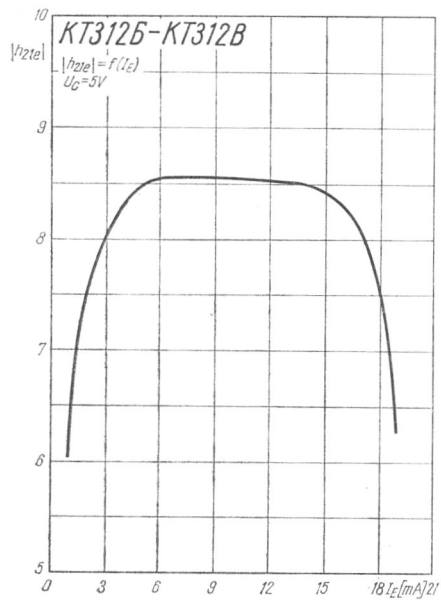
Rys. 1-1334. Zależność admitancji wyjściowej od temperatury otoczenia



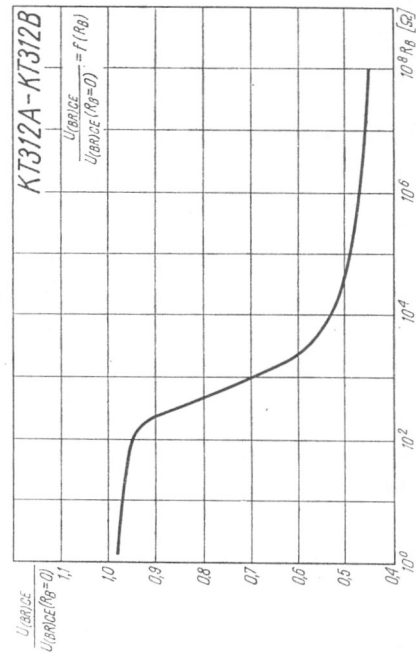
Rys. 1-1335. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od temperatury otoczenia



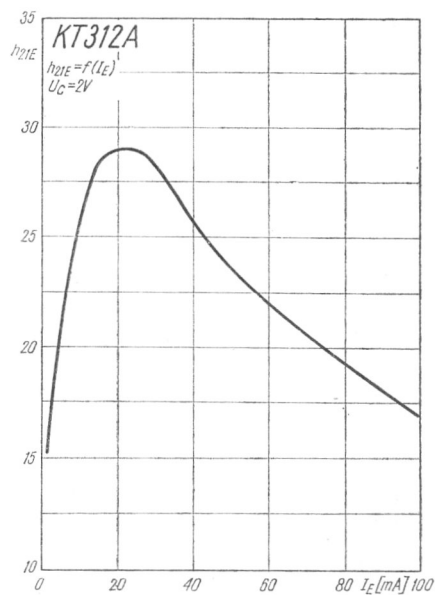
Rys. 1-1336. Zależność pojemności kolektora od napięcia kolektora



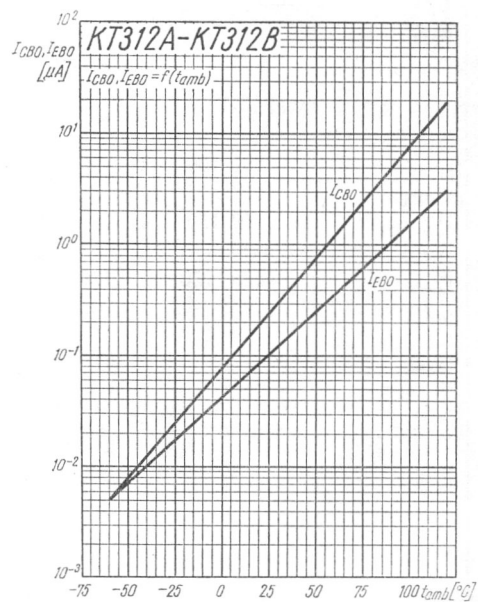
Rys. 1-1337. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu emitera



Rys. 1-1338. Zależność napięcia przebicia kolektora od rezystancji bazy



Rys. 1-1339. Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu emitera



Rys. 1-1340. Zależność prądów zerowych tranzystora od temperatury otoczenia